

H01S 光を増幅または生成するために、放射の誘導放出による光増幅 [レ - ザ] を用いた装置 ; 光領域以外の電磁放射の誘導放出を用いた装置 [2019.01]

注

このサブクラスは以下のものを包含する :

a. 単色でコヒ - レントな電磁放射を増幅または生成するための励起原子または分子による放射の誘導放出を用いた装置 ;

b. このような単色でコヒ - レントな電磁放射を変調、復調、制御または安定化するような機能。

サブクラス内の索引

メ - ザ.....	1/00
半導体レ - ザ.....	5/00
半導体レ - ザ以外のレ - ザ.....	3/00
誘導放出を用いたその他の装置.....	4/00
1/00	メ - ザ, すなわちマイクロ波領域での電磁放射の誘導放出を用いた装置 [2006.01]
1/02	・固体 [2006.01]
1/04	・液体 [2006.01]
1/06	・ガス [2006.01]
3/00	レ - ザ, すなわち赤外線, 可視光または紫外線領域での電磁放射の誘導放出を用いた装置 (半導体レ - ザ H01S5/00) [2006.01]
A	応用に特徴のあるもの
B	・レ - ザによる加工
F	・レ - ザによる測定, 観測
G	レ - ザの測定, 監視
Z	その他のもの
3/02	・構造的な細部 [2006.01]
3/03	・ガスレ - ザ放電管 [2006.01]
L	管そのものの支持, 取付, 位置調整
Z	その他のもの
3/032	・放電の制限のためのもの, 例. 放電収れん管の特徴によるもの [2006.01]
3/034	・管の中の, または管の一部を形成する光学装置, 例. 窓, 鏡 (共振器を初期調整するためのいろいろな性質または位置を有する反射鏡 H01S3/086) [2006.01]
3/036	・管の中の望ましいガス圧力を取得または維持するための手段, 例. 残留ガスの除去または補充; ガスを循環させるための手段, 例. 管の中の圧力を均等にするためのもの [2006.01]
3/038	・電極, 例. 特別の形状, 相対的配置または構造 [2006.01]
A	電極の材料
B	誘電作用を用いるもの
Z	その他のもの
3/04	・冷却装置 [2006.01]
3/041	・ガスレ - ザのためのもの [2006.01]
3/042	・固体レ - ザのためのもの [2006.01]
3/05	・光学的な共振器の構造または形状; 活性媒質の調整; 活性媒質の形状 [2006.01]
3/06	・活性媒質の構造または形状 [2006.01]
3/063	・導波路型レ - ザ, 例. レ - ザ増幅器 [2006.01]
3/067	・ファイバ型レ - ザ [2006.01]

3/07	・複数の部分から成るもの, 例. セグメント (H01S3/067 が優先) [2006.01]
3/08	・光学的共振器またはその部分の構造または形状 [2006.01]
3/081	・3 個以上の反射鏡からなるもの [2006.01]
3/082	・複数の共振器を限定するもの, 例. モ - ド選択用 [2006.01]
3/083	・リングレ - ザ [2006.01]
3/086	・共振器を初期調整するためのいろいろな性質または位置を有する 1 個以上の反射鏡 (動作中のレ - ザ出力のパラメータを変化させるもの H01S3/10, レ - ザ出力の安定 H01S3/13) [2006.01]
3/09	・励起方法またはその装置, 例. ポンピング [2006.01]
3/091	・光学的ポンピングを用いるもの [2006.01]
3/0915	・インコヒ - レント光によるもの [2006.01]
3/092	・フラッシュランプのもの (H01S3/0937 が優先) [2006.01]
3/093	・励起エネルギーを活性媒質に集中または向けるもの [2006.01]
3/0933	・半導体のもの, 例. 発光ダイオード [2006.01]
3/0937	・爆発物質または可燃性物質により生じるもの [2006.01]
3/094	・コヒ - レント光によるもの [2006.01]
3/0941	・半導体レ - ザの, 例. レ - ザ - ダイオードの [2006.01]
3/0943	・ガスレ - ザのもの [2006.01]
3/0947	・有機色素レ - ザのもの [2006.01]
3/095	・化学または熱ポンピングを用いるもの [2006.01]
3/0951	・レ - ザガス媒質の圧力増加によるもの [2006.01]
3/0953	・ガスダイナミックレ - ザ, すなわちレ - ザガス媒質の膨脹が超音速流速に達するもの [2006.01]
3/0955	・高エネルギー - 粒子によるポンピングを用いるもの [2006.01]
3/0957	・高エネルギー - 原子核粒子によるもの [2006.01]
3/0959	・電子ビームによるもの [2006.01]
3/097	・ガスレ - ザのガス放電によるもの [2006.01]
A	放電回路
Z	その他のもの
3/0971	・横切って励起されるもの (H01S3/0975 が優先) [2006.01]
3/0973	・活性媒質を通過する進行波を有するもの [2006.01]
3/0975	・誘導性または容量性の励起を用いるもの [2006.01]
3/0977	・補助の電離手段を有するもの [2006.01]
3/0979	・ガスダイナミックレ - ザ, すなわちレ - ザガス媒質の膨脹が超音速流速に達するもの [2006.01]
3/098	・モ - ドロッキング; モ - ド抑制 (複数の共振器を用いるモ - ド抑制 H01S3/082) [2006.01]

3/10	・放出された放射線の強度、周波数、位相、偏光または方向の制御、例、スイッチング、ゲート、変調または復調（モードロッキング H01S3/098）[2006.01]	3/223	・・・活性ガスが多原子、すなわち 2 個以上の原子を含むもの（H01S3/227 が優先）[2006.01]
D	光増幅器	3/225	・・・エキシマまたはエキシブレックスからなるもの [2006.01]
Z	その他のもの	3/227	・・・金属蒸気 [2006.01]
3/101	・・・レ - ザ放射線の放出位置または方向を変える手段を備えたレ - ザ [2006.01]	3/23	・H01S3/02-3/14 に分類されない 2 個以上のレ - ザの配列、例、分離された活性媒質の直列配列（半導体レ - ザのみを含むもの H01S5/40）[2006.01]
3/102	・・・活性媒質を制御することによるもの、例、励起方法または励起装置を制御することによるもの（H01S3/13 が優先）[2006.01]	3/30	・散乱効果、例、誘導ブリリュアン効果またはラマン効果、を利用するもの [2006.01]
3/104	・・・ガスレ - ザにおけるもの [2006.01]	A	自由電子レ - ザ
3/105	・・・共振器の反射鏡の相対位置または反射特性を制御することによるもの（H01S3/13 が優先）[2006.01]	Z	その他のもの
3/1055	・・・回折格子によって構成されている反射鏡の 1 つを制御するもの [2006.01]	4/00	グル - プ H01S1/00, H01S3/00 または H01S5/00 に包含されるものとは異なった領域での電磁放射の誘導放出を用いた装置、例、フォノンメ - ザ、X 線レ - ザまたはガンマ線レ - ザ [2006.01]
3/106	・・・共振器内に置かれた素子の制御によるもの（H01S3/13 が優先）[2006.01]	5/00	半導体レ - ザ（ス - パ - ルミネッセントダイオ - ド H01L33/00）[2006.01]
3/107	・・・電気 光学素子を用いるもの、例、ポッケルス効果またはカ - 効果を示すもの [2006.01]	IPC がどの版の化学元素周期表を参照しているかを示すセクション C のタイトルに続く注（3）に注意すること。このグル - プで用いられる周期システムは、周期表においてロ - マ数字で表示された 8 つのグル - プからなるシステムである。[2010.01]	
3/108	・・・非線形光学素子を用いるもの、例、ブリリュアン散乱またはラマン散乱を示すもの [2006.01]	5/02	・レ - ザ作用にとって本質的ではない構造的な細部または構成 [2006.01]
3/109	・・・周波数通倍、例、高調波の発生 [2006.01]	5/022	・・・マウント ; ハウジング [2006.01]
3/11	・・・光学的な共振器の性質を急激に変化するもの、すなわちジャイアントパルス技術 [2006.01]	5/024	・・・冷却装置 [2006.01]
3/113	・・・漂白可能な媒質またはソ - ラライジング媒質を用いるもの [2006.01]	5/026	・・・モノリシックに集積された複数の構成、例、導波管、モニタ - 用フォトデテクタ - または駆動素子（出力の安定化 H01S5/06）[2006.01]
3/115	・・・電気 光学装置を用いるもの [2006.01]	5/026 610	・・・光素子との集積（H13.5 新設）
3/117	・・・音響 光学装置を用いるもの [2006.01]	5/026 612	・・・受光素子との集積（H13.5 新設）
3/121	・・・機械的装置を用いるもの [2006.01]	5/026 616	・・・光変調器との集積（H13.5 新設）
3/123	・・・鏡を回転させるもの [2006.01]	5/026 618	・・・受動導波路との集積（H13.5 新設）
3/125	・・・プリズムを回転させるもの [2006.01]	5/026 650	・・・その他の素子との集積、例、駆動素子、ヒ - タ素子（H13.5 新設）
3/127	・・・複数の Q スイッチを用いるもの [2006.01]	5/028	・・・コ - ティング [2006.01]
3/13	・・・レ - ザ出力パラメ - タ、例、周波数、振幅、の安定 [2006.01]	5/04	・励起方法またはその装置、例、ポンピング（H01S5/06 が優先）[2006.01]
3/131	・・・活性媒質を制御することによるもの、例、励起方法または励起装置を制御することによるもの [2006.01]	5/042	・・・電氣的励起 [2006.01]
3/134	・・・ガスレ - ザにおけるもの [2006.01]	5/042 610	・・・細部構造（H11.5 新設）
3/136	・・・共振器内に置かれた装置を制御することによるもの [2006.01]	5/042 612	・・・電極（H13.5 新設）
3/137	・・・周波数を安定化するためのもの [2006.01]	5/042 614	・・・コンタクト層（H13.5 新設）
3/139	・・・共振器の反射鏡の相対位置または反射特性を制御することによるもの [2006.01]	5/042 630	・・・回路（制御用回路は 5/06 から 5/0687 に分類）（H11.5 新設）
3/14	・活性媒質として使用する物質に特徴のあるもの [2006.01]	5/06	・レ - ザ出力パラメ - タの制御、例、活性媒質を制御することによるもの [2006.01]
3/16	・・・固体物質 [2006.01]	5/062	・・・電極に印加する電圧を変えることによるもの（H01S5/065 が優先）[2006.01]
3/17	・・・非晶質、例、ガラス [2006.01]	5/0625	・・・多分割レ - ザにおけるもの [2006.01]
3/20	・・・液体 [2006.01]	5/065	・・・モ - ドロッキング ; モ - ド抑制 ; モ - ド選択 [2006.01]
3/207	・・・キレ - トを含むもの [2006.01]	5/065 610	・・・自励発振型レ - ザ（H13.5 新設）
3/213	・・・有機色素を含むもの [2006.01]	5/068	・・・レ - ザ出力パラメ - タの安定化（H01S5/0625 が優先）[2006.01]
3/22	・・・ガス [2006.01]	5/0683	・・・光学的な出力パラメ - タをモニタすることによるもの [2006.01]
		5/0687	・・・レ - ザの周波数を安定化させるもの [2006.01]

-
- 5/10 ・光共振器の構造または形状 [2006.01]
 - 5/12 ・・周期構造を有する共振器, 例 . 分布帰還型レ - ザ [DFB レ - ザ] におけるもの (H01S5/18 が優先) [2006.01]
 - 5/125 ・・・分布反射型レ - ザ [DBR レ - ザ] [2006.01]
 - 5/14 ・・外部共振器型レ - ザ (H01S5/18 が優先 ; モ - ドロッキング H01S5/065) [2006.01]
 - 5/16 ・・窓構造レ - ザ, すなわち活性領域と反射面との間に非吸収材料からなる領域を持つもの (H01S5/14 が優先) [2006.01]
 - 5/18 ・・表面放出型レ - ザ [SEL] [2006.01]
 - 5/183 ・・・垂直共振器を有するもの [VCSEL] [2006.01]
 - 5/187 ・・・分布ブラッグ反射器を用いるもの [SE - DBR レ - ザ] (H01S5/183 が優先) [2006.01]
 - 5/20 ・半導体本体の光を導波する構造または形状 [2006.01]
 - 5/20 610 ・・積層方向の光閉じ込め構造 (H13.5 新設)
 - 5/22 ・・リッジまたはストライプ構造を有するもの [2006.01]
 - 5/22 610 ・・・複数のリッジまたはストライプ構造を有するもの, 例 . 位相同期型アレイ, マルチビ - ム型 (H11.5 新設)
 - 5/223 ・・・埋込みストライプ構造のもの (H01S5/227 が優先) [2006.01]
 - 5/227 ・・・埋込みメサ構造のもの [2006.01]
 - 5/24 ・・溝を有するもの, 例 . V 溝型 [2006.01]
 - 5/30 ・活性領域の構造または形状 ; 活性領域に用いられる材料 [2006.01]
 - 5/32 ・・PN 接合からなるもの, 例 . ヘテロまたはダブルヘテロ構造 (H01S5/34, H01S5/36 が優先) [2006.01]
 - 5/323 ・・・A_{III}B_V 族化合物におけるもの, 例 . AlGaAs レ - ザ [2006.01]
 - 5/323 610 ・・・・V 族元素が N であるもの (H13.5 新設)
 - 5/327 ・・・A_{II}B_{VI} 族化合物におけるもの, 例 . ZnCdSe レ - ザ [2006.01]
 - 5/34 ・・量子井戸または超格子構造を含むもの, 例 . 単一量子井戸型レ - ザ [SQW レ - ザ], 多重量子井戸型レ - ザ [MQW レ - ザ], 傾斜屈折率型分離閉じ込めヘテロ構造レ - ザ [GRINSCH レ - ザ] (H01S5/36 が優先) [2006.01]
 - 5/343 ・・・A_{III}B_V 族化合物におけるもの, 例 . AlGaAs レ - ザ [2006.01]
 - 5/343 610 ・・・・V 族元素が N であるもの (H13.5 新設)
 - 5/347 ・・・A_{II}B_{VI} 族化合物におけるもの, 例 . ZnCdSe レ - ザ [2006.01]
 - 5/36 ・・有機材料からなるもの [2006.01]
 - 5/40 ・H01S5/02-H01S5/30 に分類されない 2 個以上の半導体レ - ザの配列 (H01S5/50 が優先) [2006.01]
 - 5/42 ・・表面放出型レ - ザの配列 [2006.01]
 - 5/50 ・H01S5/02-H01S5/30 に分類されない増幅器の構造 [2006.01]
 - 5/50 610 ・・光増幅器 (H11.5 新設)
 - 5/50 630 ・・光制御装置の構造, 例 . 光スイッチ, フィルタ, 論理回路, 変調器 (光制御装置自体は G02F) (H11.5 新設)
-

